

シリコン トランジスタ

**Silicon Transistors** 

# 2SA1413,1413-Z

## PNP 三重拡散形シリコントランジスタ 高速度高耐圧スイッチング用

#### 特徵

○高耐圧です。

 $V_{CEO} = -600 \text{ V}$ 

○スイッチングスピードが速い。

 $t_{on}, t_f \leq 0.5 \mu s$ 

#### 品質水準

○標準(一般電子機器用)

品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料「NEC 半導体デバイスの品質水準」(IEI-620)をご覧ください。

#### 絶対最大定格 (T<sub>a</sub> = 25 ℃)

項	E	略	号	定	格	単	位
コレクタ・ベース間電圧		$V_{CBO}$		-600		v	
コレクタ・エミッタ間電圧		V <sub>CEO</sub>		-600		v	
エミッタ・ベ	ース間電圧	$V_{EBO}$		_	- 7	V	,
コレクタ電	流(直 流)	I <sub>C(DC</sub>	:)	_	1.0	A	
コレクタ電	流(パルス)	I <sub>C(pul</sub>	se) *		2.0	A	
全 損	失	$P_T$	**		10	W	ī
ジャンクシ	ョン温度	T <sub>j</sub>		1	150	°C	;
保 存	保 存 温 度			- 55 ·	~ + 150	°C	;

<sup>\*</sup>PW $\leq$ 10 ms, Duty Cycle $\leq$ 50 %

 $<sup>**</sup>T_C = 25$  °C

#### 電気的特性 $(T_a = 25 \degree C)$

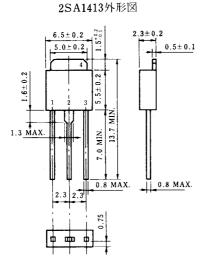
項	B	略	号	条	件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタし	、ゃ 断電流	$I_{CBO}$		$V_{CB} = -600 \text{ V}, I_E = 0$				-10	μA
エミッタし	、ゃ断電流	I <sub>EBO</sub>		$V_{EB} = -7.0 \text{ V, } I_{C} = 0$				- 10	$\mu$ <b>A</b>
直流電流	荒 増 幅 率	$h_{FE1}$	***	$V_{CE} = -5.0 \text{ V}, I_{C} = -0.1$	A	30	58	120	_
直流電流	<b>荒増幅率</b>	h <sub>FE2</sub>	***	$V_{CE} = -5.0 \text{ V}, I_{C} = -0.5$	A	5	19		
コレクタ	飽和電圧	V <sub>CE(sat</sub>	***	$I_C = -0.3 \text{ A, } I_B = -0.06$	A		-0.28	-1.0	V
ベース食	包和電圧	V <sub>BE(sat</sub>	***	$I_C = -0.3 \text{ A}, I_B = -0.06$	A		-0.85	-1.2	v
コレク	タ 容 量	Сов		$V_{CB} = -10 \text{ V}, I_E = 0, f = 1$	.0 MHz		42		pF
利 得 帯	域 幅 積	f <sub>T</sub>		$V_{CE} = -10 \text{ V, } I_{C} = -0.05$	A		28		MHz
9 - > 7	ナン時間	ton		$I_C = -0.5 A, R_L = 500 \Omega$			0.1	0.5	μs
蓄 積	時 間	tstg		$I_{B1} = -I_{B2} = -0.1 \text{ A}$			3.5	5.0	μs
下 降	時 間	t <sub>f</sub>		$V_{\rm CC} = -250 \text{ V}$			0.08	0.5	μs

\*\*\*パルス測定 PW≤350 μs, Duty Cycle≤2 %

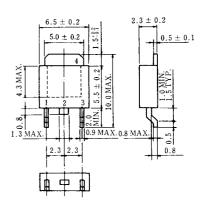
#### hFE規格区分

捺 印	M	L	K		
h <sub>FE1</sub>	30~60	40~80	60~120		

#### 外形図 (単位:mm)



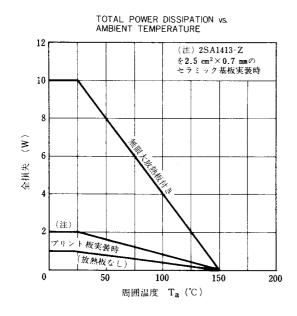
#### 2SA1413-Z外形図

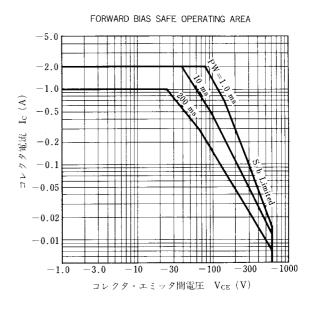


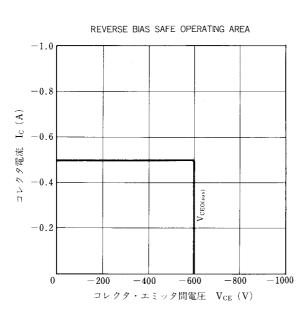
#### 電極接続

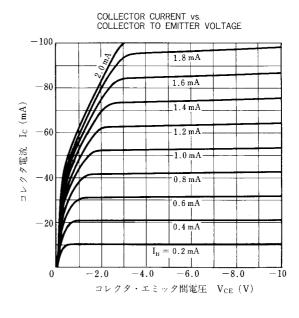
- 1. ベース
- 2. コレクタ
- 3. エミッタ
- 4. コレクタ (フィン)

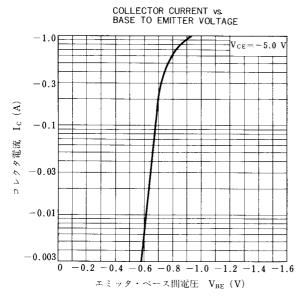
#### 特性曲線(Ta = 25 ℃)

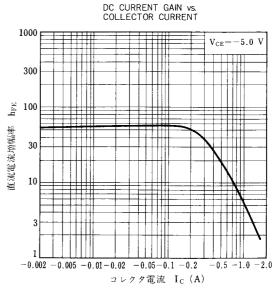


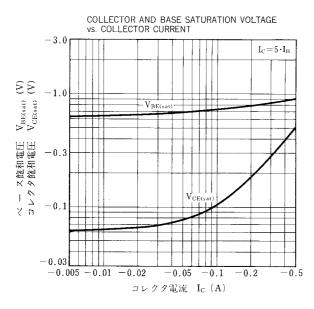


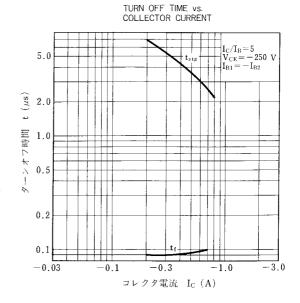


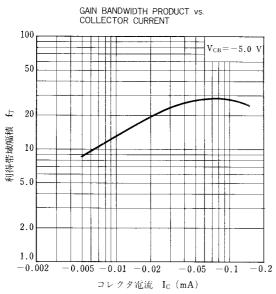


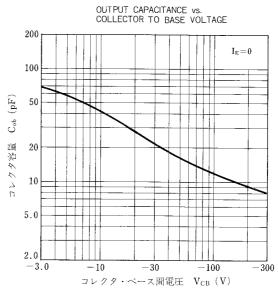


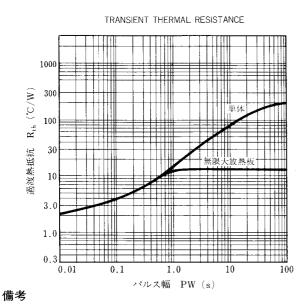












2SA1413-Zは、半田付け条件 235℃ 5 秒半田リフロ法にて半田付けを行ってください。

Ŧ)

- ○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- ○本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三 者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に 起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんの でご了承ください。
- ○当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体 製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対 策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- ○当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定 して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われること を意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準:コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機 器 産業用ロボット

特別水準:輸送機器(自動車、列車、船舶等)、交通用信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、 生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準:航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機 器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製 品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必 ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

○この製品は耐放射線設計をしておりません。

- ○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- ○この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の 構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
- ○当社は,航空宇宙機器,海底中継器,原子力制御システム,生命維持のための医療用機器など極めて 高い信頼性が要求される『特定』用途に推奨できる製品を標準的には用意しておりません。当社製品 を『特定』用途にご使用をお考えのお客様、および、『標準』品質水準品を当社が意図した用途以外に ご使用をお考えのお客様は、事前に販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

当社推奨の用途例

標準:コンピュータ,OA機器,通信機器,計測機器,工作機械,産業用ロボット,AV機器,家電等 特別:輸送機器(航空機,列車、自動車等)、交通信号機器、防災/防犯装置等

○この製品は耐放射線設計をしておりません。

## NEC 日本電気株式会社

社 〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)

— 導 第 \* 〒108-01 東京都港区 芝五丁目 7 番 1 号(日本電気本社ビル) 東京(03)3454 - | | | | 

関 西 支 社  $\mp 540$  大阪市中央区城見一丁目 4 番24号(日本電気関西ビル) 大 版 $(\mathbf{O6})$   $\mathbf{945}$  -  $\mathbf{3}$   $\mathbf{178}$  と 半導体販売部

中 部 支 社 〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中日ビル) 名古崖(**052**)242-2755 半導体販売部

北東岩山郡 美女女女女女女女女女女女女女女女女 幌(011)231-0161 台(022)261-5511 匈(0196)51-4344 形(0236)23-5511 山(0249)23-5511 回(0249)23 55 1 1 つき(0246)21 - 5 5 1 1 岡(0258)36 - 2 1 5 5 戸(0292)26 - 1 7 1 7 神 奈 馬 五 支 支 支 支 樺 (045)324-551 高 崎(0273)26-1255 太 田(0276)46-4011 宇都宮(0286)21-2281 (0285) 24 - 5 0 1 1 (0262) 35 - 1 4 4 4 本(0263)35-1666 訪(0266)53-5350 河(0552)24-4141 宮(048)641-1411 支 本支店諏訪支店 松諏甲大

川(0425)26-09|| 葉(0472)27-544| 岡(054)255-22|| 津(0559)63-4455 静沼浜北福 津松 松(053)452-27 I I 沢(0762)23-162 I 井(0776)22-1866 店社社社店 111(0764)31 - 8461富京神中鳥 戸(078)332-島(082)242-5504 取(0857)27-53 I I 山(0862)25-4455 松(0878)36-I 200 取 四新松 九北 医美支支支 支支支支支支方法 化加州 大大 地名 新居浜(0897)32-5001 松 山(0899)45-4111 福 岡(092)271-7700 北九州(093)541-2887 九州

#### (技術お問い合せ先)

半導体応用技術本部 第一応用システム技術部	〒108 01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	東 京(03)3798-6105
半導体応用技術本部 第二応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁日 4 番24号(日本電気関西ビル)	大 阪 (06)945-3383
半導体応用技術本部 第三応用システム技術部	〒460 名古屋市中区栄购丁目14番5号(松下中日ビル)	名古屋 (052) 242 - 2762
半導体応用技術本部 メモリ・汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三月目484番地	川 崎(044)548-8882

インフォメーションセンター FAX(044)548 7900

### **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:

Click to view products by Renesas manufacturer:

Other Similar products are found below:

619691C MCH4017-TL-H BC546/116 BC556/FSC BC557/116 BSW67A HN7G01FU-A(T5L,F,T NJVMJD148T4G

NSVMMBT6520LT1G NTE187A NTE195A NTE2302 NTE2330 NTE2353 NTE316 IMX9T110 NTE63 NTE65 C4460 SBC846BLT3G

2SA1419T-TD-H 2SA1721-O(TE85L,F) 2SA1727TLP 2SA2126-E 2SB1202T-TL-E 2SB1204S-TL-E 2SC4731T-AY 2SD2150T100R

SP000011176 FJPF5304DTU FMC5AT148 FMMTA92QTA 2N2369ADCSM 2SB1202S-TL-E 2SB1324-TD-E 2SC2412KT146S

2SC3332T 2SC3902S 2SC4618TLN 2SC5231C8-TL-E 2SC5490A-TL-H 2SD1685F 2SD1816S-TL-E 2SD1816T-TL-E CMXT2207 TR

CPH6501-TL-E MCH4021-TL-E TTC012(Q) BULD128DT4 US6T6TR